

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成20年12月18日(2008.12.18)

【公開番号】特開2007-191765(P2007-191765A)

【公開日】平成19年8月2日(2007.8.2)

【年通号数】公開・登録公報2007-029

【出願番号】特願2006-12092(P2006-12092)

【国際特許分類】

C 23 C 14/06 (2006.01)

B 23 B 27/14 (2006.01)

B 23 C 5/16 (2006.01)

B 23 B 51/00 (2006.01)

【F I】

C 23 C 14/06 P

B 23 B 27/14 A

B 23 C 5/16

B 23 B 51/00 J

【手続補正書】

【提出日】平成20年10月29日(2008.10.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0029】

また前記第2の層も、少なくとも一部(特に全部)が、さらにSi及び/又はBを含有していてもよい。このSi及び/又はBを含有する第2の層は、下記式(2b)で示される点を除き、前述の通常の第2の層(2a)と同じである[なお下記式(2b)は、Bが炭窒化物を形成したもののみならず、Bが、Zr、Hf、Siなどと硼化物を形成したものも含む]。

(Zr_(1-k-m-n)Hf_kSi_mB_n) (C_(1-y)N_y) ... (2b)

[式中の添字は、原子比を示す。m及びnは、片方が0であってもよい。これら添字は、以下の関係を満足する。

$$\frac{0}{0} < \frac{k}{(m+n)} < \frac{1-m-n}{0.2} \quad]$$

“m+n”的限定理由及び好ましい範囲は、前記“b+c”的場合と同様である。またm及びnの片方が0になってよい理由等についても、前記b、cの場合と同様である。kの好ましい範囲は、前記式2aの場合と同様である。